

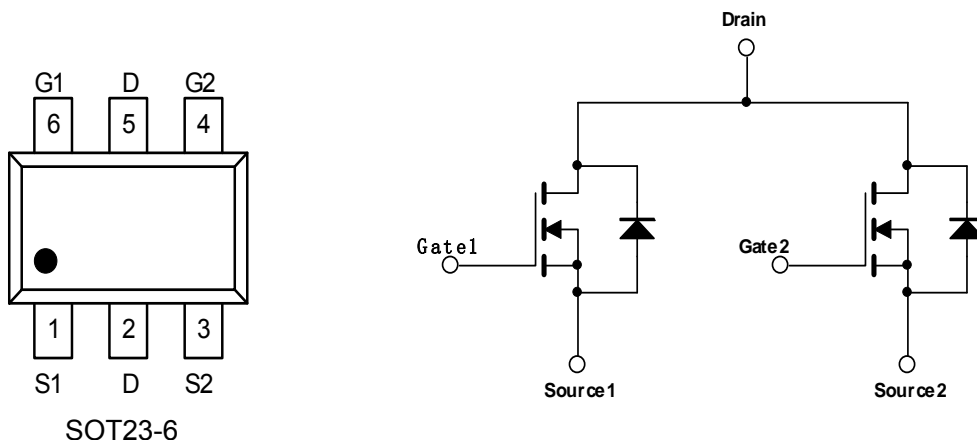


深圳市富满电子集团股份有限公司

SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

8205SS (文件编号: S&CIC1478)

N 沟道功率 MOS 场效应应用管



绝对最大额定值 (TA=25°C, 除非另有说明。)			
参数	符号	值	单位
漏源电压	V _{DS}	20	V
栅源电压	V _{GS}	±8	V
漏极电流	I _D	5	A
漏极脉冲电流	I _{DM}	16	A
存储温度	T _{STG}	-55 to +150	°C
工作结温	T _J	-55 to +150	°C

电特性 (TA=25°C, 除非另有说明。)						
特性 (OFF)						
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _{DS} =250uA	20	--	--	V
栅源短路时漏极电流	I _{DSS}	V _{DS} =16V, V _{GS} =0V	--	--	1	uA
漏极短路时截止栅电流	I _{GSS}	V _{GS} =±8V, V _{DS} =0V	--	--	±100	nA
特性 (ON)						
栅极阈值电压	V _{GS(TH)}	V _{DS} =V _{GS} , I _{DS} =250uA	0.45	0.65	1.0	V
漏源电阻	R _{DS(ON)}	V _{GS} =4.5V, I _D =3A	--	24	30	mΩ
		V _{GS} =2.5V, I _D =2A	--	28	35	
漏源二极管特性及最大额定值						
漏源二极管正向电压	V _{SD}	V _{GS} =0V, I _{DS} =4.5A	--	--	1.3	V
栅极输入电阻	R _G	V _{GS} =0, V _{DS} =0, V Frequency=1MHZ	--	2.5	--	Ω